

特許情報開示

名古屋工業大学

開示番号	発明の名称	発明の概要	出願番号	出願日
2503001	単結晶グラフェンの製造方法、および単結晶グラフェンを用いたタッチパネル	CVDにおける炭素源とキャリアガスの種類と供給量、さらには基板配置等を工夫することにより、六角形等のドメイン状あるいは連続膜のグラフェンを提供することができる。	特願2013-016268	H25.1.31
2503002	アパタイト型ケイ酸ランタン多結晶体及びその製造方法、並びに酸化物イオン伝導体、固体電解質	特定の結晶軸が一方向に高配向したアパタイト型ケイ酸ランタン多結晶体は、YSZ等の酸化物イオン伝導体に比して500～700℃での酸化物イオン伝導度が高く、固体電解質等に利用できる。	特願2013-018102	H25.2.1
2503003	新規光学活性イミダゾリン-リン酸触媒とその誘導体	新規の不斉触媒を開発した。この触媒は、酸性部分と塩基性部分を併せ持ち、不斉反応において協奏的に機能し、高立体選択性を発現する。	特願2013-024022	H25.2.12
2503004	シリカおよびシリカと水溶性化合物との複合材料の合成方法	本発明は、水性シリカ分散液を触媒やpH調整を要することなく、シリカあるいはシリカを含む複合材料を合成できる方法である。水性物質との複合化が容易で、機能性シリカや水性物質のシリカカプセルとして利用することができる。	特願2013-026219	H25.2.14
2503005	シリカ組成物膜およびシリカを含む薄膜の合成方法	本発明は、水性シリカ分散液を触媒やpH調整を要することなく、高接着性のシリカ薄膜を簡便に合成できる。パワーデバイスや半導体材料における絶縁性薄膜として利用することができる。	特願2013-027507	H25.2.15